



- [7]S. H. Jung, S. W. Kang, Jpn.J.Appl.Phys , Vol. 40, pp. 3147, 2001.
- [8] 張怡南, 2000, 生物感測器, 生物技術的發展與應用, 九州出版社, 第三版, PP. 303~320。
- [9]簡國明, 洪長春, 吳典熹, 王永銘, 藍怡平, 奈米二氧化鈦專利地圖及分析 Titanium Dioxide, 行政院國家科學委員會科學技術資料中心, pp.18-24, 2004。
- [10] M. A. Rashti and D. E. Brodie, 1994, “ The Photoresponse of High Resistance Anatase TiO<sub>2</sub> Films Prepared by the Decomposition of Titanium isopropoxide ”, Thin Solid Films, Vol. 240, PP.163-167.
- [11] N. Rausch and E. P. Burte, 1992, “ Thin High-Dielectric TiO<sub>2</sub> Films Prepared by Low Pressure MOCVD ”, Engineering, Vo. 19, PP. 725-729.
- [12] T. Fuyuki and H. Matsunami, 1986, “ Electronic Properties of the Interface between Si and TiO<sub>2</sub> Deposited at Very Low Temperatures ”, Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 25, P.1288.
- [13] 陳繼仁, 1989, TiO<sub>2</sub> 陶瓷的燒結、電性及晶界偏析理論模型之研究, 國立清華大學, 博士論文。
- [14] D. Bloor, R. J. Brook, M. C. Flemings and S. Mahajan, “ The Encyclopedia of Advanced Materials ”, PP. 2880-2882, (Elsevier Science Ltd, 1994).
- [15]洪雨利, 溶凝膠法製備奈米二氧化鈦觸媒進行光催化還原二氧化碳之批次反映研究, 國立中山大學, 碩士論文, 2003。
- [16]L. K. Meixner, S. Koch, Simulation of ISFET operation based on the site-binding model, Sensors and Actuators B, Vol.6, pp.315-318, 1992.
- [17]牛蒙年, 丁辛芳, 童勤義, 氧化物-電解溶液界面的表面基吸附模型研究, 半導體學報, 第17卷, 第6期, 6月, pp.458-463, 1996。
- [18]廖嵐彬, 二氧化鈦酸鹼離子感測場效電晶體元件與積體化讀出電路之研究, 國立雲林科技大學, 2003。
- [19]江榮隆, 非晶形三氧化鎢場效型離子感測元件之研究, 國立雲林技術學院, 碩士論文, 1997。
- [20]H. Abe, M. Esashi, T. Matsuo, ISFET ' s using inorganic gate thin films, IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. ED-26, pp.1939-1944, 1979.
- [21]L. K. Meixner, S. Koch, Simulation of ISFET operation based on the site-binding model, Sensors and Actuators B, Vol.6, pp.315-318, 1992.
- [22] Clifford. D. Fung, Peter. W. Cheung, and Wen. H. Ko, 1986, “ A Generalized Theory of an Electrolyte-Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistor ”, IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. ED-33, PP.8-18.